

FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS :

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)					電 氣 的 特 性 (Ta=25°C)										外 形	備 考
				V _{CEO} (V)	V _{ESD} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値 (μA)	V _{CE} (V)	直 流 又 は パ ル ス h _{FE}		バ イ ア ス		h _{FE}	h _{ie}	h _{ie} *	h _{FE} *		
1	2	3	4	5					6	7		8		9	10		11	12		

- 1** TYPE NUMBER
- 2** ORIGINAL MANUFACTURER
- 3** USES
- 4** MATERIAL AND STRUCTURE
- 5** MAXIMUM RATINGS
- 6** I_{CEO} MAXIMUM VALUE AND V_{CE} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CEO})
- 7** STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE}, I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})
- 8** STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CE}, I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

- * INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.
- 9** f_{αb} OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.
- 10** C_{ob} AND r_{bb'} OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN r_{bb'} COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)
- 11** OUTLINE
- 12** REMARKS

: とコンプリ : COMPLEMENTARY TO

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外 形	備 考			
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)			f _{αβ} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie(ideal)} * (Ω)
									μA	V _{CB(V)}	V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	V _{CB(V)}	I _{E(mA)}									
★ 2SC1421	富士通	RF	Si.EP	15	3	30	250	150	0.5	10	80	6	10	6	-10	NF=6dB (f=2GHz, I _C =4mA)	5500*	0.7	25*	199			
" 1422	"	"	"	15	3	40	250	150	0.5	10	80	6	20	6	-20	"	5500*	0.8	25*	199			
★ " 1423	"	"	"	15	3	30	250	150	0.5	10	80	6	15	6	-15	NF=3.5dB (f=2GHz, I _C =4mA)	7000*	0.7	25*	199			
" 1424	日電	"	Si.E	30	3	50	250	200	0.1	15	80	10	10	10	-10	G _p =15dB (f=500MHz)	2000*	1.1		50C			
" 1425	"	PA	"	45	3	1A	11.6W (T _c =25°C)	200	100	30	15~250	10	300			G _p =5dB (f=1GHz, V _{cc} =18V, P _t =1W)				184			
" 1426	"	RF	"	35	3	200	3.5W (T _c =25°C)	200	0.1	20	100	10	50	10	-50		2700*	1		85B			
" 1427	"	RF. Conv. Mix. Osc.	"	30	4	10	100	125	0.1	25	120	6	2	6	-2		1000*	0.7	C _c r _{bb'} 3pS	176			
" 1428	"	"	"	50	5	50	150	125	0.1	15	110	3	0.5	6	-1		250*	1.5	C _c r _{bb'} 25pS	176			
" 1429	ソニー	PA	Si.E PaMe	16	6	2A	950	120	0.1	16	200	2	100	2	-10		80*	26	C _c r _{bb'} 300pS	174			
" 1430	"	RF. PA	Si.EMe	110		1.5A	500	150	100	50	100	2	400	2	-200		50*	50	C _c r _{bb'} 25pS	181			
" 1431	"	"	"	110	5	2A	1.5W	150	10	50	100	2	400	2	-100		80*	25	C _c r _{bb'} 25pS	99			
" 1432	新日無	SW	Si.EP	30	10	300	300	125	1	20	40,000	6	100			t _{on} <600nS, t _{off} <1.2μS t _{sig} <600nS				138	2SA796 とコンプリ		
★ " 1433	東芝	PA. SW	Si.TMe	600	5	5A	50W (T _c =25°C)	150	100	500	20~300	5	1A	50		t _{on} <2μS, t _f <1.5μS t _{sig} <10μS		100		102			
★ " 1434	"	"	"	600	5	15A	150W (T _c =25°C)	150	500	500	30~300	5	3A	50		t _{on} <2μS, t _f <2.5μS t _{sig} <15μS		200		102			
★ " 1435	"	"	"	600	5	40A	300W (T _c =25°C)	150	1mA	500	30~300	5	10A	50		t _{on} <11μS, t _f <1.5μS t _{sig} <10μS		600		196			
" 1436	サンケン	SW	Si.TMe	230	6	15A	100W (T _c =25°C)	150	1mA	230	20	4	5A	12	-500	t _r <1.5μS, t _f <1μS t _{sig} <4μS, t _d <0.5μS		10*		102			
" 1437	"	"	"	230	6	50A	200W (T _c =25°C)	150	1mA	230	20	4	10A	12	-500	t _r <1.5μS, t _f <1μS t _{sig} <4μS		10*		230			
" 1438	富士通	RF	Si.EP	150	5	50	500	150	1	140	150	5	10	5	-10				130*	3	138		
" 1439	"	"	"	150	5	50	500	150	1	140	150	5	10	5	-10				130*	3	138		
" 1440	サンケン	SW	Si.TMe	150	6	15A	100W (T _c =25°C)	150	1mA	150	20	4	5A	12	-500	t _r <1.5μS, t _f <1μS t _{sig} <4μS, t _d <0.5μS		10*		102			
" 1441	"	"	"	200	6	15A	100W (T _c =25°C)	150	1mA	200	20	4	5A	12	-500	t _r <1.5μS, t _f <1μS t _{sig} <4μS, t _d <0.5μS		10*		102			
" 1442	"	"	"	150	6	50A	200W (T _c =25°C)	150	1mA	150	20	4	10A	12	-500	t _r <1.5μS, t _f <1μS t _{sig} <4μS		10*		230			
" 1443	"	"	"	200	6	50A	200W (T _c =25°C)	150	1mA	200	20	4	10A	12	-500	t _r <1.5μS, t _f <1μS t _{sig} <4μS		10*		230			
" 1444	"	PA	"	80	6	6A	40W (T _c =25°C)	150	1mA	80	80	4	1A	10	-500				10*	85	12*	99	2SA764 とコンプリ
" 1445	"	"	"	100	6	6A	40W (T _c =25°C)	150	1mA	100	80	4	1A	10	-500				10*	85	12*	99	2SA765 とコンプリ
★ " 1446	松下	"	Si.TP	300	5	100	10W (T _c =70°C)	150	100	300	70	10	50	30	-20				55*	8	10	268	
" 1447	東芝	RF. PA	Si.T	300	5	150	20W (T _c =25°C)	150	1	240	40~170	10	50	50	-20				80*	7	30	268	
★ " 1448	"	"	Si.TMe	150	5	1.5A	25W (T _c =25°C)	150	20	100	75	10	500	10	-500				5*	50	25	268	
" 1449	日電	PA	Si.E	40	5	2A	10W (T _c =25°C)	150	0.5	35	90	2	300	5	-100				*55*	20	40*	225	
★ " 1450	松下	"	Si.Me	150	5	400	20W (T _c =80°C)	150	30	60	70	5	100	10	100				15*	50	25	99	2SA766 とコンプリ